

## عنوان مقاله:

بررسی تاثیر ناخالصی سیلیکون در شکل گیری عیوب کریستالی در ماده گالیم نیتراید

## محل انتشار:

کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴ (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 3

## نویسندگان:

حسین مختاری - گروه فیزیک دانشگاه یزد

نیره صحتی - گروه فیزیک دانشگاه یزد

## خلاصه مقاله:

در این کار تجربی اثرات ناخالصی سیلیکون در شکل گیری عیوب کریستالی در ماده گالیم نیتراید مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده بر روی دو نمونه گالیم نیتراید با ناخالصیهای متفاوت از سیلیکون نشان می دهد که افزایش ناخالصی فوق موجب کاهش عیوب کریستالی و توزیع یکنواخت تر آنها در ماده می شود. با توجه به اینکه عیوب کریستالی مانند تله هائی برای حاملها عمل می کنند کاهش عیوب کریستالی در ماده موجب افزایش تحرک پذیری حاملها در ماده گردیده و در نتیجه گالیم نیتراید خواص الکتریکی بهتری را از خود نشان خواهد داد

## کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/26063>

